

2005 年 3 月 30 日

超高速 DRAM、XDR™ DRAM のサンプル出荷を開始

3.2GHz の超高速データ転送動作と 16 ビット I/O 構成により、
DRAM 単体で 6.4GB / 秒のデータ転送速度を実現



エルピーダメモリ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：坂本幸雄 以下、エルピーダ）は、このたび、米国ラムバス社の超高速データ転送技術を採用した 512M ビット XDR DRAM「EDX5116ABSE」を開発し、本日よりサンプル出荷を開始いたしました。

HDTV など高精細な画像を取り扱うデジタル家電の発展は、その膨大なデータを処理するために、システムとして大きなバンド幅が必要となっております。また、これらをリアルタイムに加工するグラフィックス処理装置、高精細画像を大量に取り扱うホームサーバなど、大量のデータを瞬時に取り扱いができるメモリへの需要が高まって来ております。

エルピーダの XDR DRAM は 3.2GHz の超高速データ転送動作と 16 ビット I/O 構成により、DRAM 単体で 6.4GB / 秒のデータ転送が可能です。これは、現在 PC で主流になりつつある DDR2 SDRAM の 4 倍以上のデータ転送能力です。このため XDR DRAM は高性能なグラフィックス処理装置、高画質な HDTV 対応のホームサーバなど超高速のデータ処理が必要な分野での応用に最適です。

「エルピーダは XDR DRAM のキーサプライヤとして、この最新テクノロジーを市場に投入する上でたいへん重要な役割を果たしています。」と、ラムバス社のマーケティングディレクターである Rich Warmke 氏は述べています。

「今日のコモディティ DRAM の性能では、増大する一方の DRAM のバンド幅向上に対する要求に応えることができません。XDR DRAM は超高速メモリソリューションの選択肢として、たいへん良いポジションを確立しています。」

新製品の主な特長は以下のとおりです。

- コントローラからの 1 クロックに対して 8 個のデータを入出力する Octal Data Rate (ODR)
- 512M ビット：4M×16 ビット×8 バンク構成
- データ転送速度：2.4、3.2、4.0GHz をサポート
- 電源電圧：1.8V
- オンチップ終端 (On -Chip Termination)

本製品の量産出荷は、2005 年 9 月を予定しております。

エルピーダはデジタル家電市場での No.1 メモリベンダを目指して今後も積極的に新製品を開発してまいります。

新製品の主な仕様は別紙をご覧ください。

以 上

Rambus、Rambus ロゴは米国およびその他の国におけるラムバス社の登録商標です。その他記載されている製品名、会社名は、ラムバス社もしくは保有各社の登録商標または商標です。

ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

別紙

512M ビット XDR DRAM の主な仕様

製品名	EDX5116ABSE
製造プロセス	0.10 μ m CMOS
構成	4M \times 16 ビット \times 8 バンク
データ幅	\times 4 / \times 8 / \times 16 ビット プログラマブル
データ転送レート	2.4GHz、3.2GHz、4.0GHz
内部データパス	256 I/O@5ns サイクル
tRC	40ns
リフレッシュサイクル	16ms
電源電圧(VDD)	1.8V \pm 0.09V
パッケージ	104 ボール FBGA